









	<h2 style="color: red;">DMN10H220LQ-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN10H220LQ-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 1.6A SOT23-3
Datenblätter:	 DMN10H220LQ-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 684238 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN10H220LQ-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1.6A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	684238 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 1.6A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	220 mOhm @ 1.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	401pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant

DMN10H220LQ-7 ist neu im Original, Suche DMN10H220LQ-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN10H220LQ-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN10H220LQ-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN10H220LVT-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 1.87A TSOT26</p>	 <p>DMN10H220LE DIODES DMN10H220LE DIODES</p>	 <p>DMN10H220LQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 1.6A SOT23-3</p>	 <p>DMN10H220LVT-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 1.87A TSOT26</p>
 <p>DMN10H700S-13 Diodes Incorporated MOSFET NCH 100V 700MA SOT23</p>	 <p>DMN10H220LE-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 2.3A SOT223</p>	 <p>DMN10H700S Diodes Incorporated DMN10H700S DIODES</p>	 <p>DMN10H220LQ Diodes Incorporated DMN10H220LQ DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

DMN1032UCB4-7	DMN1033UCB4	DMN1053UCP4	DMN1054UCB4	DMN1054UCB4-7
DMN10H099SFGQ-13	DMN10H099SK3	DMN10H099SK3-13	DMN10H100SK3	DMN10H120SE
DMN10H120SE-13	DMN10H120SFG	DMN10H120SFG-7	DMN10H120SFG-7	DMN10H170SFDE
DMN10H170SFDE-7	DMN10H170SFDE-7	DMN10H170SK3	DMN10H170SK3-13-79	DMN10H170SVT-7
DMN10H170SVTQ-7	DMN10H220L-7	DMN10H220LE	DMN10H220LE-13	DMN10H220LQ
DMN10H220LVT-7	DMN10H700S	DMN10H700S-7	DMN1150UFB-7B	DMN13H1750S-7
DMN13H750S-7	DMN15H310SE-13	DMN2004DMK	DMN2004DMK-7	DMN2004DWK-7
DMN2004DWK-7-F	DMN2004K-7	DMN2004K-7-F	DMN2004TK-7	DMN2004TK-7-F
DMN2004VK	DMN2004VK-7	DMN2004VK-7-G	DMN2004WK-7	DMN2004WKQ-7
DMN2005DLP4K-7	DMN2005K-7	DMN2005K-7-F	DMN2005LP4K-7	DMN2005LPK-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited